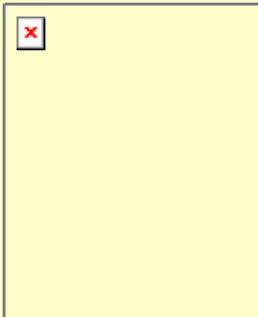


## 本期封面



2000年2

栏目:

DOI:

论文题目: ITO薄膜的XPS和AES研究

作者姓名: 陈猛, 裴志亮, 白雪冬, 黄荣芳, 闻立时

工作单位: 中国科学院金属研究所

通信作者: 闻立时

通信作者Email:

文章摘要: 分别用XPS和AES分析了ITO薄膜真空退火前后各元素化学状态的变化和深度分布情况. 研究表明, 退火前后Sn和In处于各自相同的化学状态中. O以氧充足和氧缺乏两种化合状态存在, 其结合能值分别为 $(529.90 \pm 0.30)$  eV和 $(531.40 \pm 0.20)$  eV. 氧缺位状态主要分布在薄膜表层. 各元素在薄膜体内分布均匀而在膜基界面存在金属富集.

关键词: 化学状态, 光电子能谱, 俄歇电子能谱,

分类号:

关闭